

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 5 月 24 日 (2007.5.24)

【公開番号】特開 2005-353789 (P2005-353789A)
 【公開日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-050
 【出願番号】特願 2004-172123 (P2004-172123)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/8246 (2006.01)

H 0 1 L 27/105 (2006.01)

H 0 1 L 43/08 (2006.01)

H 0 1 L 43/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/10 4 4 7

H 0 1 L 43/08 P

H 0 1 L 43/08 Z

H 0 1 L 43/12

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 29 日 (2007.3.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 7】

より具体的には、データ書込みにおいては、上述のように、ビット線 B L と書込みワード線 R W L とに電流を流して合成磁界を生成させるが、この合成磁界の大きさがアステロイド曲線の少し外側となるように設定し、この合成磁界の半分程度を、それぞれ、ビット線 B L 及び書込みワード線 R W L によって生成させる。尚、このような状態を「半選択」状態と呼ぶ。このような「半選択」状態とすることで、電流が流されているビット線 B L と電流が流されている書込みワード線 R W L との交点に位置するトンネル磁気抵抗素子 T M J にはデータが書き込まれる。一方、電流が流されているビット線 B L と電流が流されていない書込みワード線 R W L との交点に位置するトンネル磁気抵抗素子 T M J、あるいは、電流が流されていないビット線 B L と電流が流されている書込みワード線 R W L との交点に位置するトンネル磁気抵抗素子 T M J にはデータが書き込まれない。尚、このようなトンネル磁気抵抗素子 T M J を、便宜上、非選択トンネル磁気抵抗素子 T M J と呼ぶ。